





	<p>SI4154DY-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4154DY-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 36A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4154DY-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 16765 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4154DY-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 36A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	16765 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	3.5W (Ta), 7.8W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	36A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.3 mOhm @ 15A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	105nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4230pF @ 20V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)








SI4154DY-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI4154DY-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4154DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4154DY-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 SI4156DY-T1-E3 VISHAY SI4156DY-T1-E3 VISHAY	 SI4143DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 25.3A 8SO	 SI4156DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 24A 8-SOIC	 SI415 Vishay Precision Group SI415 VISHAY
 SI4154DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 36A 8-SOIC	 SI4136XM-GTR SILICON SI4136XM-GTR SILICON	 SI4143DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHANNEL 30V 25.3A 8SO	 SI4156DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 24A 8-SOIC

heiße Teile

Mehr

 SI4128DY-T1-E3	 SI4128DY-T1-GE3	 SI4128DY-T1-GE3	 SI4133-D-GM	 SI4133G-BT
 SI4133T-BM	 SI4133T-BMR	 SI4133W-BMR	 SI4133X1-BMR	 SI4134DY
 SI4134DY-T1	 SI4134DY-T1-E3	 SI4134DY-T1-E3	 SI4134DY-T1-GE3	 SI4134DY-T1-GE3
 SI4134DY/T1-GE3	 SI4134T-BMR	 SI4134T-GMR	 SI4136-F-GM	 SI4136-F-GMR
 SI4136DY-T1-GE3	 SI4136DY-T1-GE3	 SI4136XM-BT	 SI4136XM-GTR	 SI4154DY-T1-GE3
 SI4156DY	 SI4156DY-T1-E3	 SI4156DY-T1-GE3	 SI4156DY-T1-GE3	 SI4160DY
 SI4160DY-T1-E3	 SI4160DY-T1-GE3	 SI4160DY-T1-GE3	 SI4160DY-TI-GE3	 SI4162DY
 SI4162DY-T1-E3	 SI4162DY-T1-GE3	 SI4162DY-T1-GE3	 SI4164DY	 SI4164DY-T1-E3
 SI4164DY-T1-GE3	 SI4164DY-T1-GE3	 SI4166DY	 SI4166DY-T1-E3	 SI4166DY-T1-GE3
 SI4166DY-T1-GE3	 SI4168DY	 SI4168DY-T1-E3	 SI4168DY-T1-GE3	 SI4168DY-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited